









	<h2 style="color: red;">IPB034N06N3GATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB034N06N3GATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 100A TO263-7
Datenblätter:	 IPB034N06N3GATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB034N06N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 100A TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 93µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPB034N06N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB034N06N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB034N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB034N06N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB034N06L3 G Infineon Technologies IPB034N06L3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB034N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 90A TO263-3</p>	 <p>IPB034N06L3G VB IPB034N06L3G VB</p>	 <p>IPB035N08N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TO263-3</p>
 <p>IPB035N08N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB035N08N3G VB IPB035N08N3G VB</p>	 <p>IPB036N12N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB034N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A TO-263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB034N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB034N06N3GATMA1 Datenblatt	IPB034N06N3GATMA1-Datenblätter	IPB034N06N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB034N06N3GATMA1
IPB034N06N3GATMA1 Electronic	IPB034N06N3GATMA1-Komponenten	IPB034N06N3GATMA1-Verteiler	IPB034N06N3GATMA1-Bild	IPB034N06N3GATMA1-Teil
IPB034N06N3GATMA1 Preis	IPB034N06N3GATMA1 Hersteller	IPB034N06N3GATMA1 Bild	IPB034N06N3GATMA1 Aktie	IPB034N06N3GATMA1 Inventar
IPB034N06N3GATMA1 Neu	IPB034N06N3GATMA1 Original	IPB034N06N3GATMA1 garantiert	IPB034N06N3GATMA1 RFQ	IPB034N06N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited